

## 产品特点

- 内置高精度电压检测电路  
过充电检测电压 4.28V 精度 $\pm 0.05V$  ;  
或 ( 过充电检测电压 4.30V 精度 $\pm 0.05V$  )  
或 ( 过充电检测电压 4.25V 精度 $\pm 0.05V$  )  
过充电解除电压 4.08V 精度 $\pm 0.05V$  ;  
过放电检测电压 2.7V 精度 $\pm 0.1V$  ;  
或 ( 过放电检测电压 2.5V 精度 $\pm 0.1V$  )  
或 ( 过放电检测电压 2.3V 精度 $\pm 0.1V$  )  
过放电解除电压 3.0V 精度 $\pm 0.1V$  ;  
过电流 1 检测电压 0.15V 精度 $\pm 0.03V$  ;  
负载短路检测电压 0.72-1.75V ;
- 单节锂离子或锂聚合物电池的理想保护电路
- 高精度的保护电压 ( 过充/过放 ) 检测
- 在过放电情况下进入低功耗模式
- 高精度过电流放电保护检测
- 电池短路保护
- 允许 0V 电池充电
- 精简的外围元器件
- 超小型化的 SOT23-6 封装

## 应用

- 锂电池的充电、放电保护电路

## 概述

RUDW01C6 系列电路是一款高精度的单节可充电锂电池的过充电和过放电保护电路, 不适用于无线和射频信号排布及屏蔽太差的产品, 它集高精度过电压充电保护、过电压放电保护、过电流放电保护等性能于一身。

正常状态下, RUDW01C6 的  $V_{DD}$  端电压在过电压充电保护阈值 ( $V_{OC}$ ) 和过电压放电保护阈值 ( $V_{OD}$ ) 之间, 且其  $V_M$  检测端电压在充电器检测电压 ( $V_{CHG}$ ) 与过电流放电保护阈值 ( $V_{O11}$ ) 之间, 此时 RUDW01C6 的  $C_{OUT}$  端和  $D_{OUT}$  端都输出高电平, 分别使外接充电控制 N-MOS 管 Q1 和放电控制 N-MOS 管 Q2 导通。这时, 既可以使用充电器对电池充电, 也可以通过负载使电池放电。

RUDW01C6 通过检测  $V_{DD}$  或  $V_M$  端电压 ( 相对于  $V_{SS}$  端 ) 来进行过充/放电保护。当充/放电保护条件发生时,  $C_{OUT}/D_{OUT}$  由高电平变为低电平, 使 Q1/Q2 由导通变为截止, 从而充/放电过程停止。RUDW01C6 对每种保护状态都有相应的恢复条件, 当恢复条件满足以后,  $C_{OUT}/D_{OUT}$  由低电平变为高电平, 使 Q1/Q2 由截止变为导通, 从而进入正常状态。

RUDW01C6 对每种保护/恢复条件都设置了一定的延迟时间, 只有在保护/恢复条件持续到相应的时间以后, 才进行相应的保护/恢复。如果保护/恢复条件在相应的延迟时间以前消除, 则不进入保护/恢复状态。

## 芯片引脚配置

封装	序号	名称	I/O	引脚说明
 <p>SOT23-6 图 1</p>	1	D <sub>OUT</sub>	O	放电控制输出端与外部放电控制 N-MOS 管 Q2 的栅极 (G 极)
	2	V <sub>M</sub>	I	充/放电电流检测输入端该引脚通过一个限流电阻 (一般为 1KΩ) 与外部控制 N-MOS 管 Q1 的源极 (S 极) 相连, 从而检/放电在两个 N-MOS 管 (Q1 和 Q2) 上形成的
	3	C <sub>OUT</sub>	O	充电控制输出端与外部充电控制 N-MOS 管 Q2 的栅极 (G 极)
	4	NC		悬空
	5	V <sub>DD</sub>	P <sub>OW</sub>	电源输入端与供电电源 ( 电池 ) 的正极连接, 该引脚需用 0.1uF 的瓷片电容去藕。
	6	V <sub>SS</sub>	P <sub>OW</sub>	电源接地端与供电电源 ( 电池 ) 的负极相连。

## 内部电路框图

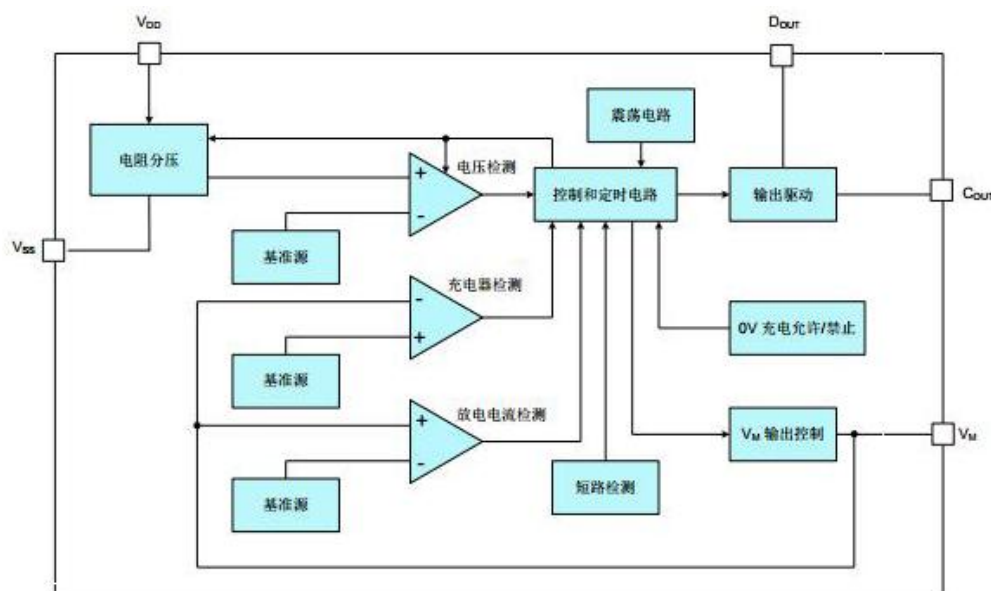


图 2

## 绝对最大额定值 (除非特殊说明, 所有管脚均以COM作为参考点)

特性	代表符号	最大工作范围	单位
电源电压	$V_{DD}$	0 -10.0	V
( $V_M$ 、 $C_{OUT}$ ) 端允许输入电压	$V_{IN}$	-25- $V_{DD}$ +0.3	V
消耗功率(环境温度25°C 时)	$P_D$	625	mW
IC 工作时的环境温度	$T_{opr}$	-40~+85	°C
IC 储存时的环境温度	$T_{stg}$	-55~+150	°C
焊接温度 (焊锡, 10秒)	$T_{stg}$	260	°C
ESD人体模式	HBM	6000	V

注1: 电压超过绝对最大额定值, 可能会损坏芯片。芯片长久地工作在推荐的工作条件之上, 可能会影响其可靠性。不建议芯片在推荐的工作条件之上长期工作。

注2: 在任何情况下, 不要超过 $P_D$ 。

## 直流特性

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
<b>工作电压</b>						
$V_{DD}$ - $V_{SS}$ 工作电压	$V_{DD}$ - $V_{SS}$	--	1.5	--	10	V
$V_{DD}$ - $V_M$ 工作电压	$V_{DD}$ - $V_M$	--	0	--	28	V
<b>消耗电流</b>						
正常工作时消耗电流	$I_{DD}$	$V_{DD}=3.9V$	--	3.0	6.0	uA
低功耗工作电流	$I_{PDN}$	$V_{DD}=V_M=2.0V$	--	0.7	1.0	uA
<b>检测电压</b>						
过充电检测电压	$V_{OC}$	--	4.23	4.28	4.33	V
过充电释放电压	$V_{OCR}$	--	4.03	4.08	4.13	V
过放电检测电压	$V_{OD}$	--	2.30	2.40	2.50	V
过放电释放电压	$V_{ODR}$	--	2.90	3.00	3.10	V
过电流 1 检测电压	$V_{OI1}$	--	0.12	0.15	0.18	V
过电流 2 (短路电流) 检测电压	$V_{OI2}$	$V_{DD}=3.6V$	0.72	1.36	1.75	V
充电器检测电压	$V_{CHG}$	--	-0.86	-0.5	-0.27	V
0V 充电允许电压阈值	$V_{0V\_CH}$	充电器电压	1.2	--	--	V
<b>延迟时间</b>						
过充电检测延迟时间	$T_{OC}$	$V_{DD}=3.6V\sim 4.4V$	--	110	160	ms
过放电检测延迟时间	$T_{OD}$	$V_{DD}=2.0V\sim 3.6V$	--	55	80	ms
过电流 1 检测延迟时间	$T_{OI1}$	$V_{DD}=3.6V$	5	7	10	ms

过电流 2 (短路电流) 检测延迟时间	$T_{OI2}$	$V_{DD}=3.6V$	--	400	600	us	
过电流放电恢复延迟时间	$T_{OIR}$		1.2	1.8	2.4	ms	
<b>输出电阻</b>							
$C_{OUT}$	管脚输出电阻“H”	$R_{OCH}$	--	1.0	5.0	15.0	$K\Omega$
	管脚输出电阻“L”	$R_{OCL}$	--	--	4.0	--	$M\Omega$
$D_{OUT}$ 管脚输出电阻“H”		$R_{ODH}$	--	1.0	5.0	15.0	$K\Omega$
$D_{OUT}$ 管脚输出电阻“L”		$R_{ODL}$	--	5	15	30	$K\Omega$
<b>VM 内部电阻</b>							
$V_M$ 至 $V_{DD}$ 之间的上拉电阻		$R_{VMD}$	--	150	300	450	$K\Omega$
$V_M$ 至 $V_{SS}$ 之间的下拉电阻		$R_{VMS}$	--	15	30	45	$K\Omega$

- 注：1、如无特殊说明，所有的电压均相对于VSS而言的；  
2、参加应用电路；  
3、以上温度范围系设计保证值，并非高低温的实际测试筛选。

## 功能描述

RUDW01C6 是一款高精度的锂电池保护电路。正常状态下，如果对电池进行充电，则 RUDW01C6 可能会进入过电压

充电保护状态；同时，满足一定条件后，又会恢复到正常状态。如果对电池放电，则可能会进入过电压放电保护状态或过电流放电保护状态；同时，满足一定条件后，也会恢复到正常状态。图 3 示出了其典型应用线路图，图 4 是其状态转换图。下面就各状态进行详细描述。

### 正常状态

在正常状态下，RUDW01C6 由电池供电，其  $V_{DD}$  端电压在过电压充电保护阈值  $V_{OC}$  和过电压放电保护阈值  $V_{OD}$  之间， $V_M$  端电压在充电器检测电压 ( $V_{CHG}$ ) 与过电流放电保护阈值 ( $V_{OI1}$ ) 之间， $C_{OUT}$  端和  $D_{OUT}$  端都输出高电平，外接充电控制 N-MOS 管 Q1 和放电控制 N-MOS 管 Q2 均导通。此时，既可以使用充电器对电池充电，也可以通过负载使电池放电。

### 过电压充电保护状态

#### 保护条件

正常状态下，对电池进行充电，如果使  $V_{DD}$  端电压升高超过过电压充电保护阈值  $V_{OC}$ ，且持续时间超过过电压充电保护延迟时间  $t_{OC}$ ，则 RUDW01C6 将使充电控制端  $C_{OUT}$  由高电平转为  $V_M$  端电平（低电平），从而使外接充电控制 N-MOS 管 Q1 关闭，充电回路被“切断”，即 RUDW01C6 进入过电压充电保护状态。

#### 恢复条件

有以下两种条件可以使 RUDW01C6 从过电压充电保护状态恢复到正常状态：1) 电池由于“自放电”使  $V_{DD}$  端电压低于过电压充电恢复阈值  $V_{OCR}$ ；2) 通过负载使电池放电（注意，此时虽然 Q1 关闭，但由于其体内二极管的存在，使放电回路仍然存在），当  $V_{DD}$  端电压低于过电压充电保护阈值  $V_{OC}$ ，且  $V_M$  端电压高于过电流放电保护阈值  $V_{OI1}$ （在 Q1 导通以前， $V_M$  端电压将比  $V_{SS}$  端高一个二极管的导通压降）。RUDW01C6 恢复到正常状态以后，充电控制端  $C_{OUT}$  将输出高电平，使外接充电控制 N-MOS 管 Q1 回到导通状态。

RUDW01C6 进入过电压充电保护状态后，如果外部一直有充电器，致使 VM 电压小于充电器检测电压（V<sub>CHG</sub>），那么即使当其 V<sub>DD</sub> 降至 V<sub>O<sub>CR</sub></sub> 以下，RUDW01C6 不会恢复到正常状态。此时必须去掉充电器，RUDW01C6 会回到正常状态。

### 过电压放电保护/低功耗状态

#### 保护条件

正常状态下，如果电池放电使 V<sub>DD</sub> 端电压降低至过电压放电保护阈值 V<sub>OD</sub>，且持续时间超过过电压放电保护延迟时间 t<sub>OD</sub>，则 RUDW01C6 将使放电控制端 D<sub>OUT</sub> 由高电平转为 V<sub>SS</sub> 端电平（低电平），从而使外接放电控制 N-MOS 管 Q2 关闭，放电回路被“切断”，即 RUDW01C6 进入过电压放电保护状态。同时，VM 端电压将通过内部电阻 R<sub>VMD</sub> 被上拉到 V<sub>DD</sub>。在过电压放电保护状态下，VM 端（亦即 V<sub>DD</sub> 端）电压总是高于电池短路保护阈值 V<sub>O<sub>I2</sub></sub>，满足此条件后，电路会进入“省电”的低功耗模式。此时，V<sub>DD</sub> 端的电流将低于 0.7 $\mu$ A。

#### 恢复条件

对于处在低功耗模式下电路，如果对电池进行充电（同样，由于 Q2 体内二极管的存在，此时的充电回路也是存在的），使 RUDW01C6 电路的 V<sub>M</sub> 端电压低于电池短路保护阈值 V<sub>O<sub>I2</sub></sub>，则它将恢复到过电压放电保护状态，此时，放电控制端 D<sub>OUT</sub> 仍为低电平，Q2 还是关闭的。如果此时停止充电，由于 V<sub>M</sub> 端仍被 R<sub>VMD</sub> 上拉到 V<sub>DD</sub>，大于电池短路保护阈值 V<sub>O<sub>I2</sub></sub>，因此 RUDW01C6 又将回到低功耗模式；只有继续对电池充电，当 V<sub>DD</sub> 端电压大于过电压放电保护阈值 V<sub>OD</sub> 时，RUDW01C6 才可从过电压放电保护状态恢复到正常状态。

如果不使用充电器，由于电池去掉负载后的“自升压”，可能会使 V<sub>DD</sub> 端电压超过过电压放电恢复阈值 V<sub>O<sub>DR</sub></sub>，此时 RUDW01C6 也将从过电压放电保护状态恢复到正常状态；RUDW01C6 恢复到正常状态以后，放电控制端 D<sub>OUT</sub> 将输出高电平，使外接充电控制 N-MOS 管 Q2 回到导通状态。

### 过电流放电/电池短路保护状态

#### 保护条件

正常状态下，通过负载对电池放电 RUDW01C6 电路的 V<sub>M</sub> 端电压将随放电电流的增加而升高。如果放电电流增加使 V<sub>M</sub> 端电压超过过电流放电保护阈值 V<sub>O<sub>I1</sub></sub>，且持续时间超过过电流放电保护延迟时间 T<sub>O<sub>I1</sub></sub>，则 RUDW01C6 进入过电流放电保护状态；如果放电电流进一步增加使 V<sub>M</sub> 端电压超过电池短路保护阈值 V<sub>O<sub>I2</sub></sub>，且持续时间超过短路延迟时间 T<sub>O<sub>I2</sub></sub>，则 RUDW01C6 进入电池短路保护状态。

RUDW01C6 处于过电流放电/电池短路保护状态时，D<sub>OUT</sub> 端将由高电平转为 V<sub>SS</sub> 端电平，从而使外接放电控制 N-MOS 管 Q2 关闭，放电回路被“切断”；同时，VM 端将通过内部电阻 R<sub>VMS</sub> 连接到 V<sub>SS</sub>，放电负载取消后，VM 端电平即变为 V<sub>SS</sub> 端电平。

#### 恢复条件

在过电流放电/电池短路保护状态下，当 V<sub>M</sub> 端电压由高降低至低于过电流放电保护阈值 V<sub>O<sub>I1</sub></sub>，且持续时间超过过电流放电恢复延迟时间 T<sub>O<sub>IR</sub></sub>，则 RUDW01C6 可恢复到正常状态。因此，在过电流放电/电池短路保护状态下，当所有的放电负载取消后，RUDW01C6 即可“自恢复”RUDW01C6 恢复到正常状态以后，放电控制端 D<sub>OUT</sub> 将输出高电平，使外接充电控制 N-MOS 管 Q2 回到导通状态。

#### 充电器检测

RUDW01C6 处于过电压放电保护状态下，如果外部接有充电器，致使 VM 端电压低于充电器检测电压（V<sub>CHG</sub>），则只要 RUDW01C6 的 V<sub>DD</sub> 电压大于 V<sub>OD</sub>，RUDW01C6 即可恢复到正常状态；如果充电器电压不能使 V<sub>M</sub> 端电压低于 V<sub>CHG</sub>，则 V<sub>DD</sub> 电压必须大于 V<sub>O<sub>DR</sub></sub>，RUDW01C6 才能恢复到正常状态。这就是通常所说的充电器检测功能。

### 0V 电池充电

对于 0V 电池充电允许的电路，如果使用充电器对电池充电，使 RUDW01C6 电路的  $V_{DD}$  端相对  $V_M$  端的电压大于 0V 充电允许阈值  $V_{OV\_CH}$  时，其充电控制端  $C_{OUT}$  将被连接到  $V_{DD}$  端。若该电压能够使外接充电控制 N-MOS 管 Q1 导通，则通过放电控制 N-MOS 管 Q2 的体内二极管可以形成一个充电回路，使电池电压升高；当电池电压升高至使  $V_{DD}$  端电压超过过电压放电保护阈值  $V_{OD}$  时，RUDW01C6 将回到正常状态，同时放电控制端  $D_{OUT}$  输出高电平，使外接放电控制 N-MOS 管处于导通状态。

注：当电池第一次接上保护电路时，这个电路可能不会进入正常模式，此时无法放电。如果产生这种现象，使 VM 管脚电压等于  $V_{SS}$  电压（将  $V_M$  与  $V_{SS}$  短路或连接充电器），就可以进入正常模式。

## 应用电路

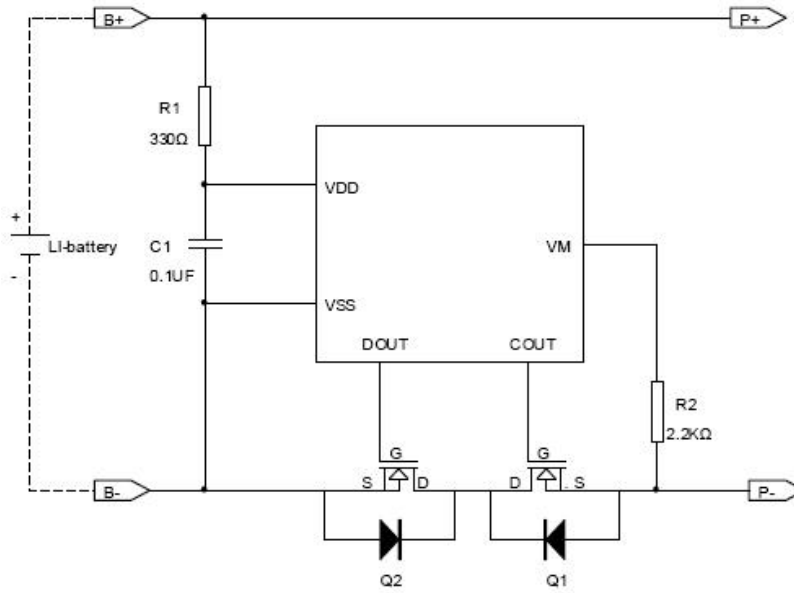


图3

## 状态工作转换表述

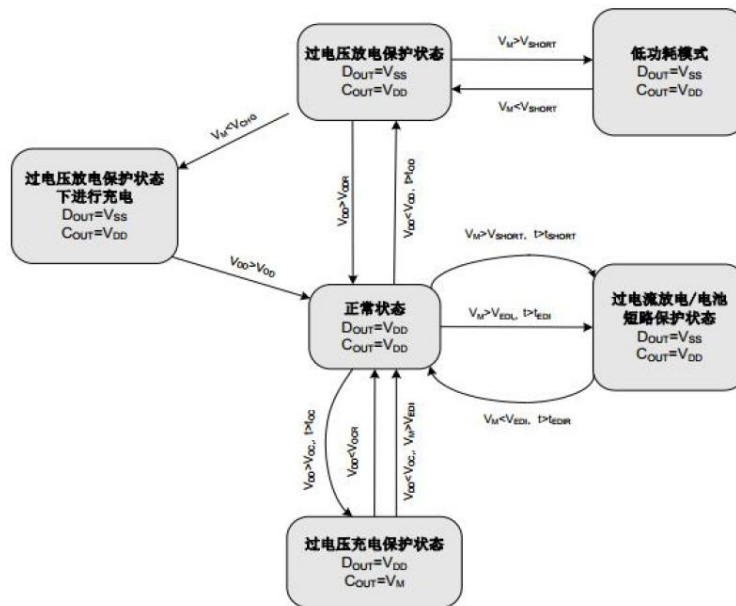


图4



## 状态转换波形图

过电压充电保护和过电压放电保护状态

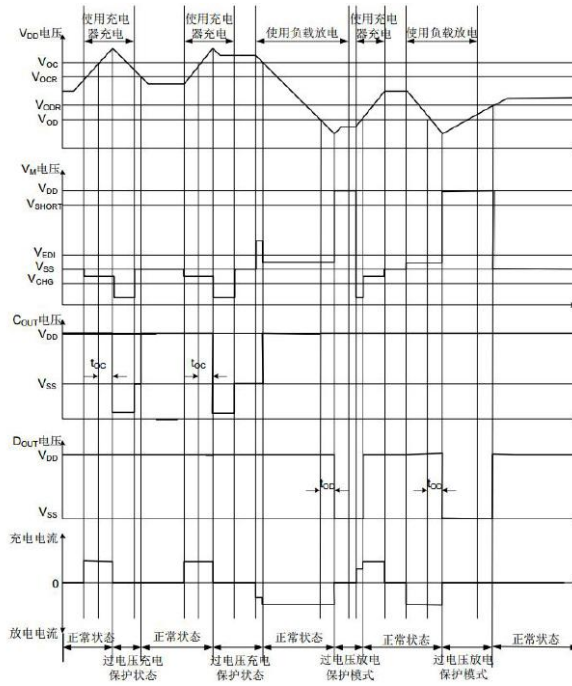


图 5

过电流放电/电池短路保护状态

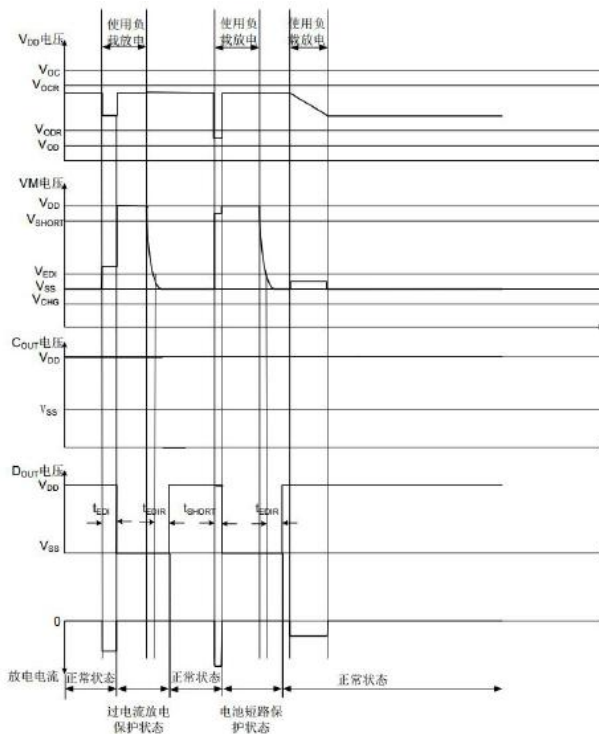


图 6

## 元器件选择

**Q1 和 Q2 的选择** Q1 和 Q2 可以选择同型号的 N-MOS 管，其栅极-源极开启电压  $V_{GS(th)}$  在 0.4V 与过电压放电保护阈值  $V_{OD}$  之间。如果  $V_{GS(th)}$  小于 0.4V，则可能会导致过电压充电保护保护时，Q1 不能有效的“关闭”；如果  $V_{GS(th)}$  大于  $V_{OD}$ ，则可能会在未进入过电压放电保护状态下，Q2 提前“关闭”，同时，Q1 和 Q2 的栅极-源极承受电压  $V_{GS}$  应大于使用充电器时  $V_{DD}$  端的电压，否则在对电池充电过程中，可能会导致 Q1 和 Q2 的损坏。

**R1 和 R2 的确定** R1 的推荐使用 330Ω 的电阻，R2 的推荐使用 2.2kΩ 的电阻，要求 R1 的阻值小于 R2。因为各种检测阈值是对于 RUDW01C6 电路  $V_{DD}$  端电压而言，而  $V_{DD}$  端通过 R1 与电池连接，如果 R1 太大，将会导致各检测阈值与电池实际电压偏差增加；同时，如果充电器接反，可能会使 RUDW01C6 电路的  $V_{DD}$  端与  $V_{SS}$  端电压超过极限值，导致电路损坏，因此 R1 不宜太大，应控制在 1kΩ 以内。

R2 不宜太小，当充电器接反或充电器充电电压太高时，它可以作为限流电阻来保护 RUDW01C6 电路；同时 R2 亦不能太大，否则当充电器充电电压太高时，充电电流将不能被有效“切断”，因此，R2 应控制在 500Ω 至 2.2kΩ 之间。

**C1 的确定**，C1 与 R1 构成滤波网络，对  $V_{DD}$  端电压进行去藕。C1 可选择 0.1μF 的陶瓷电容。

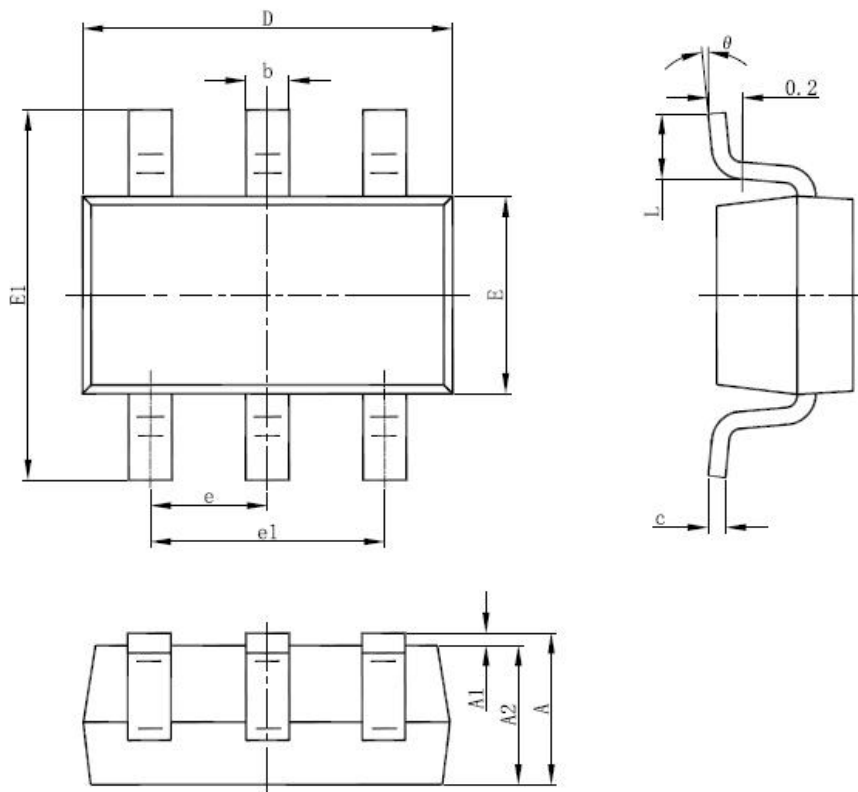
## 订购信息

型号	标示	封装	包装方式	数量	卷带大小	卷带宽度
RUDW01C6	DW01	SOT23-6	编带真空静电袋	3000		



## 封装

### RUDW01C6-SOT23-6



符号	公制/单位mm		英制/单位 inch	
	最小尺寸	最大尺寸	最小尺寸	
A	1.050	1.250	0.041	0.049
A1	0.000	0.100	0.000	0.004
A2	1.050	1.150	0.041	0.045
b	0.300	0.500	0.012	0.020
c	0.100	0.200	0.004	0.008
D	2.820	3.020	0.111	0.119
E	1.500	1.700	0.059	0.067
E1	2.650	2.950	0.104	0.116
e	0.950 (BSC)		0.037 (BSC)	
e1	1.800	2.000	0.071	0.079
L	0.300	0.600	0.012	0.024
θ	0°	8°	0°	8°